第二章

文獻回顧

2.1 原子轉移自由基聚合

2.1.1 可控/活性自由基聚合概述

活性聚合反應中依據引發機制理論不同,可分為陽離子活性聚 合、陰離子活性聚合、配位活性聚合及自由基活性聚合等。迄今發 展最完善者為陰離子活性聚合,由此可成功地獲得單分散聚合物、 預定結構及序列的團聯共聚物、接枝共聚物。然而,由於陰離子活 性聚合對反應條件要求嚴苛、可聚合單體種類少,導致應用範圍受 限;因此與其他類型聚合反應相較之下,自由基聚合可聚合的單體 種類多、反應條件溫和而容易控制、易實現工業化生產,因此活性 自由基聚合具有極高的實用價值,無論工業界與學術界皆積極發展 新的可控/活性自由基聚合(controlled/ living radical polymerization, CRP)方法,並試圖瞭解其中反應機制。例如:可逆加成-裂解鏈轉移 聚合(reversible addition-fragmentation transfer, RAFT)、氮氧自由基控 制聚合(nitroxide mediated polymeri-zation, NMP)或穩定自由基聚合 (stable free radical polymerization, SFRP)皆屬於 CRP 常用的聚合方 法。

對於傳統的自由基聚合法(free radical polymerization, FRP)而 言,存在不可逆鏈終止反應及鏈轉移反應,而無法控制聚合物分子 結構及大小,且通常分子量分佈很寬。因此可控/活性自由基聚合具 有四個明顯區別於傳統自由基聚合之反應特徵¹:

- (1)引發反應速率遠大於成長反應速率,幾乎不存在鏈終止及鏈轉移 反應,因此所有聚合物鏈同時成長、且成長數目不變,因此分子 量分佈(polydispersity index, PDI)很窄。
- (2) 聚合物分子量正比於消耗單體濃度/起始劑初始濃度比。
- (3)聚合物分子量隨轉化率成線性增長,可透過控制單體及起始劑進 料比以控制高分子之聚合度。
- (4)在第一單體之轉化率達100%時,再加入其他單體,可合成具有 特定結構之團聯共聚物、或新型高分子材料。

2.1.2 反應機制

1995 年, Matyjaszewski²及Sawamoto³兩個研究小組,分別發表 以過渡金屬作為催化劑之原子轉移自由基聚合(atom transfer radical polymerization, ATRP),其可有效地改善反應過程中自由基數目過多 的缺點,因此亦屬於CRP的一種,其反應機制如圖 2.1 所示⁴。

R-X +
$$M_t^n$$
-Y / Ligand $\underbrace{\frac{k_{act}}{k_{deact}}}_{monomer}$ R + X- M_t^{n+1} -Y / Ligand $\underbrace{k_p}_{k_t}$ termination

圖 2.1 原子轉移自由基聚合之反應機制

起始劑(initiator, R-X)上的鹵素原子轉移至過渡金屬錯合物 (M_tⁿ-Y/Ligand,Y代表另一配位基或對離子),使金屬氧化而產生具有 活性的自由基,且活性自由基的失活(deactivation)反應速率大於休眠 種(dormant species)的活化(activation)反應速率,因此系統中的自由 基濃度極低,從而抑制自由基鏈間的終止反應,進一步地有效控制 所需要的分子量及分子量分佈(PDI)狹窄的聚合物(1.0 < M_w/M_n < 1.5)。

由反應機制得知,ATRP 關鍵在於使主鏈於低濃度自由基環境中 成長。為有效控制自由基聚合,在此可逆反應過程中必須趨於休眠 反應,而降低活化自由基反應速率,使反應中整體的自由基濃度保

持極低狀態,因此不可逆的終止反應相對地變慢而將可被忽略,分 子量增加是由單體加成而得,而不須考慮控制鏈終止反應、鏈轉移 反應及其他副反應。再者,休眠反應與活化反應的交換速率必須大 於鏈成長反應,如此方可確保每一條高分子鏈與單體反應具有相同 的反應性,若以上條件為適當的,則可利用活性自由基聚合法製備 分子量分佈狹窄的高分子。

2.1.3 反應條件控制

在ATRP反應系統中,隨著起始劑、催化劑、配位基、單體取代基、反應溫度與時間...等條件不同,則反應結果有所差異,以下將對各項變因做簡單的描述^{4,5}。

- (1)起始劑:ATRP之起始劑多為鹵烷類(RX),由於鹵素原子(X)可以 在烷鏈(R)及錯鹽間快速轉移,如此可保護自由基而不會彼此結 合。此外,RX 的反應性隨鹵素原子粒徑大小而增加,但反應性 太高則不易控制分子量,因此大多數使用 Br 或 Cl,反應性之大 小則為 3°RX > 2°RX > 1°RX。
- (2)催化劑:ATRP 所使用的過渡金屬必須容易進行單價電子的氧化、還原反應,此有助於鹵素原子的加入及離去,因此稱之為原子轉移活性自由基聚合,而非電子轉移。此外,過渡金屬對自由基的反應要低於鹵素原子,且須為弱的路易士酸(Lewis acid),如此才可確保起始劑能夠完全反應。統整有效的ATRP 反應催化劑必須具備以下四點特性:
 - (a) 快速起始自由基的生成, 確保所有高分子鏈瞬間開始成長。
 - (b)活性自由基(free radical)與休眠種(dormant species)間的可逆

平衡反應要趨向休眠反應,降低自由基濃度。 (c)藉由鹵素原子轉移使得活性自由基快速失活,以確保所有高 分子鏈具有相同的生長速率,如此方可獲得分子量分佈狹窄的高分子。

(d)所使用的觸媒不會導致其他副反應的發生,例如:自由基的 氧化還原反應。

許多過渡金屬錯合物曾被應用於 ATRP,例如:Ru(II)、Ni(II)、 Fe(II)、Rh(I)、Cu(I)等,如圖 2.2。此類金屬所形成之錯合物都能 經由可逆的氧化還原反應,控制溶液中自由基的濃度,其中由於亞 銅錯合物催化效果最佳,並且符合經濟效益,因此被廣泛地應用於 聚合反應中。



圖2.2 以過渡金屬錯合物作為原子轉移自由基聚合之催化劑 (3)配位基:在ATRP反應中配位基扮演極為重要的角色。由於金屬 錯鹽不溶於非極性溶劑中而將導致反應性不佳,因此配位基的另 一項功能即為增加金屬錯鹽之溶解度,以利反應進行,其可提升 過渡金屬鹽類在有機溶液中的溶解度,使非均相(heterogeneous) 轉為均相(homogeneous)反應,並且可以調整中心金屬的氧化還原

電位,進而影響催化劑活性。氮原子會與具空d軌域之金屬離子 產生配位鍵結,其中採用亞銅鹽類與含氮的配位基錯合,可獲得 良好的活性。

(4)單體:大多數烯類皆可適用於ATRP,包括:苯乙烯(styrene)、丙烯酸酯(acrylate)、甲基丙烯酸酯(methacrylate)及其具不同官能基 之衍生物,如圖 2.3。但由於丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯系列之單 體活性太大,易使金屬錯鹽氧化而失去催化機能,因此選用單體 反應仍受些微限制。



圖 2.3 適用原子轉移自由基聚合反應之單體

(5)溶劑與添加劑:ATRP 可利用總體(Bulk)聚合法操作,若單體與聚 合物不互溶時,則可需藉由溶劑或乳化方式進行反應,但必須需 考慮是否會發生取代反應,因此大多選擇非離子性之有機溶劑及 添加劑,有利於自由基擴散而得以順利地控制分子量。

- (6)反應溫度:提高溫度雖有助於成長反應進行,但同時亦增加終止 反應的機率。由於平衡常數為溫度的函數,因此需有適當的反應 溫度以考量轉化率及分子量分佈。
- (7)反應時間:隨著反應時間增加,單體隨之減少,自由基之間的鍵 結相對於單體反應的機率將會提高,因此轉化率達一定程度後, 分子量分佈將會變寬。

2.1.4 高分子設計

整體而言,原子轉移自由基聚合具有選用單體範圍廣泛、反應 條件溫和等優點,此外由於原子轉移自由基聚合反應中的起始劑可 快速、完全地反應生成自由基,並且在反應單體間快速交換,因此 藉由調整起始劑及單體比率,並掌握起始劑的化性、結構與末端基 團,即可對不同單體進行聚合反應,以獲得所預期之分子量、及分 子量分佈狹窄的高分子。同時藉由微結構型態設計,使組成多樣化 (composition variables)及內部作用力參數(Interaction parameters),分 別聚合出不同幾何變化(星狀、梳狀、樹枝狀)、構造變化(不規則、 週期性、枝鏈性)及活性基團於不同位置(末端、側面、中心)之高分 子材料,如圖 2.4,因此對於合成與設計新型高分子材料而言,原子 轉移自由基聚合法為一強而有利的工具。

Composition	1 CCCC000000 Block Copolymers	Statistical Copolymers	GOGCCOGCOCCO Gradient Copolymers	Graft Copolymers
<u>Topology</u> Linear	Star / Multi - Armed	Comb Polymers	Networks	(Hyper)Branched
Functionalit X(Y) Homo/Hetero Telechelic	Y X A Macromonome	rs Multi - Armer	x x x x x x Side Functional Groups	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Molecular Co	omposites	X X X X X X X popolymers	Functional Colloids	Modified Surfaces

圖 2.4 藉由原子轉移自由基聚合製備出新型高分子

2.2 自由基聚合

2.2.1 自由基聚合概述

自由基聚合反應整個過程可由鏈起始、鏈成長及鏈終止三個基本反應所組成,起始活化能為105~150 kJ/mol、成長活化能為16~33 kJ/mol、終止活化能為8~12 kJ/mol,因此「起始慢、增長快、終止快」為自由基聚合動力學之基本特徵,也因此聚合過程中存在大量鏈轉移及鏈終止反應,包括:偶合終止及歧化終止,因此分子量及分子量分佈變得不可控制¹。

但由於自由基聚合具備使用單體廣泛、合成方法多樣、製備工 藝簡便及工業化成本低等優點,因此目前大部份塑膠、彈性體、纖 維均以自由基聚合反應製得,而成為工業上極為重要的合成方法。

2.2.2 起始劑種類

自由基聚合反應是由一活性成分 R·作為起始反應,此種活性成 分由起始劑(initiator)分解而得,因此反應中經常使用的起始劑 (initiator)其種類包括:過氧化物、偶氮化合物、氧化還原起始劑、 光起始劑...等。例如:偶氮異丁腈 2,2'-azo-bisisobutyronitrile (AIBN)、phenyl-azo-triphenylmethane、tert-butyl-peroxide (TBP)、cumyl peroxide、過氧化二苯甲醯 bnezoyl peroxide (BPO)、tert-butyl perbenzoate,不同的自由基起始劑對各種聚合物的分配並無影響,

但對反應速率有所差異。

2.2.3 自由基反應機制

自由基聚合反應整個過程可由鏈起始、鏈成長及鏈終止三個基本反應所組成,以下就各基本反應步驟進行描述。

(1) 鏈起始反應(initiation)-

由起始劑分解而成的自由基與單體結合成為自由基鏈。(k_d 為 起始劑分解速率常數、k_i為起始步驟速率常數)

 $I \xrightarrow{k_d} 2R \cdot R \cdot + M \xrightarrow{k_i} M_i^{\cdot} (起始反應)$

自由基聚合反應中,起始反應為速率決定步驟,其與起始劑 分子分解成自由基之速率有關,一但產生自由基時,則單體將以 極快的速度進行成長反應,進而獲得長鏈高分子,因此自由基聚 合反應能在極短時間內獲得極高分子量之聚合物。但反應中的起 始劑濃度很低,通常為10⁻⁹~10⁻⁷ mol/L,假設R_i為起始反應速率, 則起始反應速率方程式如下。

$$R_{i} = \frac{-d[M]}{dt} = \frac{d[RM \bullet]}{dt} = ki[R \bullet][M]$$

(2) 鏈成長反應(propagation)-

自由基鏈連續與單體結合成為更長的自由基鏈。一般而言, 成長反應速率常數與聚合體鏈長無關,因此下列反應速率式中M₂ 、M₃...M_n及M_{n+1}可視為相同。(kp為成長反應速率常數)

$$M_{i}^{*} + M \xrightarrow{k_{p}} M_{i}^{*}$$

$$M_{i}^{*} + M \xrightarrow{k_{p}} M_{i}^{*}$$

$$\vdots$$

$$M_{n}^{*} + M \xrightarrow{k_{p}} M_{n+1} (\vec{\alpha} \in \mathbf{\xi}, \mathbf{k})$$

成長反應速率為單體隨時間消耗速率,可以下列方程式表示。 $R_{P} = \frac{-d[M]}{dt} = K_{P}[M][M \bullet]$

在任一聚合反應時間內,反應混合物中僅含有聚合單體、高 子量聚合物及成長中的聚合分子鏈。雖然總轉化率隨著反應時間 增加而變大,但由於各步驟反應之活化能相差很大,因此時間對 分子量影響不大。所以當高分子量聚合物個數增加同時,單體濃 度隨之降低,而聚合物的分子量卻始終相對地一直保持不變,所 得聚合體分子量與單體濃度成正比,與起始劑濃度平方根成反比。 (3) 鏈終止反應(termination)-

成長中的聚合鏈會因自由基中心於兩個自由基分子進行終止 反應而停止生長。若由兩個自由基結合的終止反應,稱為鏈偶合 反應(combination);若由某自由基中心的β氫自由基,轉移至另一 自由基中心的終止反應,稱為鏈歧化反應(disproportionation)。若 反應不傾向終止反應進行,則成長反應將一直持續至聚合單體用 完為止。(k_{tc}為偶合反應速率常數、k_{td}為歧化反應速率常數)

$$M_{n} + M_{m} \xrightarrow{k_{tc}} M_{n+m}$$
 (鏈偶合反應)
 $M_{n} + M_{m} \xrightarrow{k_{td}} M_{n} + M_{m}$ (鏈歧化反應)

終止反應速率與單位時間的自由基濃度有關,以下列方程式表示。

$$R_{t} = \frac{-d[M \bullet]}{dt} = 2kt[M \bullet][M \bullet] = 2kt[M \bullet]^{2}$$

2.2.4 影響反應因素

(1)起始劑效應

在聚合過程中,起始劑濃度增加,則系統中自由基濃度變高, 達到臨界鏈長的數目減少,寡分子鏈聚集過程增加。

(2) 溫度效應

當反應溫度升高,則提供能量加速分解起始劑而生成自由 基,此時自由基濃度提高、產生自由基的起始速率加快,成長反 應速率隨之加快,同時亦促使終止反應加速進行,此作用為互相 影響、制約的結果。此外隨著反應溫度升高,系統中由自由基濃 度增加,引發形成聚合物之分子量降低,且因終止反應加速進行, 導致聚合物分子量分佈變大。

(3) 溶劑效應

聚合反應所使用的溶劑必須能溶解單體、起始劑及生成之高 分子,但應避免自由基轉移至溶劑上而限制分子量成長。此外, 溶劑使系統黏度降低,自由基的擴散速度和相互碰撞機率增大, 將促使自由基以歧化或偶合方式終止反應。

2.3 雙親性團聯共聚合物

2.3.1 團聯共聚合物概述

團聯共聚合物(block copolymers)由兩種(或以上)不同化學性質 之高分子鏈藉由化學鍵所組成;由於團聯物種間化學成分不相同, 造成彼此不互容效應,因此自組裝形成所謂的微觀相分離 (microphase separation),最終將自有序成熱力學上之最低吉布斯自由 能(Gibbs free energy)的穩定有序微結構,同時微結購之排組尺寸約 在數十奈米之間,其特殊相行為,分別敘述如下:

(1)團聯共聚合物於熱熔狀態下之相行為

在熱熔狀態下相分離而自組裝成不同形貌,並具有週期性排列 之微結構,為團聯共聚合物材料引人注目的特性之一。由於高分子 鏈段組成不同,使熱力學狀態亦有所不同,造成兩鏈段高分子間不 互容,進而產生具週期性之微相分離行為。又高分子鏈段間以共價 鍵連結,不致於產生巨大的相分離行為,因此形成多種不同的高分 子相形態(morphology),此團聯高分子的相形態與鏈段間的相容度、 組成比例、溫度、分子量有關,其形態包括:層狀結構(lamellar)、 柱狀結構(cylinder)、球狀結構(sephere)、六方堆積(HEX)、體心 (BCC)、面心(FCC)...等,如圖2.6。



圖 2.6 團聯共聚合物之微相分離形貌⁶

(2)團聯共聚合物在稀薄溶液中之相行為

若所選用的溶劑對高分子特定鏈段具有選擇性時,團聯共聚合物會因為該鏈段具有較高的溶解度而較易展開,而另一鏈段則因為 溶解度較差而捲曲,使溶液傾向於形成微胞(micelle)溶液。因此,同 時具有兩種不同特性的高分子鏈段,藉由在稀薄溶液中特有的性 質,可輕易的以微胞或乳化的形式在微米(或奈米)尺度上均匀的分散 開,而使此材料同時具有兩種高分子鏈段的特性。一般而言,微胞 現象發生在具有狹窄分子量分佈、及均匀的分子量大小之團聯共聚 合物所形成的一種動態平衡系統。



圖2.7 團聯共聚合物於選擇性溶劑中之形貌⁷

(3) 團聯共聚合物薄膜之相行為

團聯共聚合物材料除了在熱熔及溶液狀態中具有自組裝能力 外,在薄膜型態上亦具備自組裝成奈米級規則有序結構的能力。一般 而言,較常使用外加電場(electric field)、側向力誘導(shear force induced)、結晶方向誘導(crystallization induced)與基材限制方向性誘 導(substrateconfined)...等,利用外來驅動力使層狀、柱狀或球狀薄膜 具大面積化及均方向性。

2.3.2 雙親性團聯共聚合物之特性及應用

將上述團聯共聚合物之其中一鏈段以親水性高分子取代使成為 親水鏈段,而另一端為疏水鏈段之雙親性團聯共聚合物(amphiphilic block copolymers)。雙親性團聯共聚物之分子結構同時包含親、疏水 鏈段而具不同化學性質,此外鏈段間亦具有化學作用力,因此可藉 由調整高分子鏈之重複單位、親疏水鏈段長度差異、具官能基結構 或選擇性溶劑...等,控制雙親性團鏈式共聚合物之不同形貌。同於 團聯共聚合物之相分離方式可形成多種特殊型態,除了受 Flory-Huggins y 參數影響之外,另外受兩鏈段高分子之特性、結構 不同或彼此間作用力因素...等,而共同影響形成特殊結構。此外尚 可選用不同溶劑變化結構之形貌,若選擇同時可溶解親疏水兩鏈段 高分子之溶劑,當溶劑揮發時將會伴隨著發生連續性的相分離,並 直到最穩定的狀態為止。倘若選擇僅溶解一端高分子鏈段時,則此 共聚合物在溶劑中先以自組裝方式成某種特殊結構,不需經由製 膜、揮發溶劑過程,即可擁有自組裝特性。

根據研究⁸,雙親性團聯共聚物可用以改善特殊投遞藥物之低治 療效果、並且可避免不需要的副反應;此外所形成之高分子微胞,在 生物醫藥應用上可作為疏水性藥物之投遞載體。此外奈米相分離之雙 親性團聯共聚合物亦可用以製備奈米粒子⁹、或奈米孔洞材料。

2.4 多孔性薄膜材料

2.4.1 文獻回顧

近年來,由於次微米至微米等級之微孔洞結構可構成具更多空間的組織,因此規則性的孔洞材料對光學、分離技術或催化反應等領域而言為重要的研究¹⁰。一般而言,可製備出孔洞材料的規則性模板包括:團聯共聚合物(block copolymers)¹¹、膠質晶體(colloidal crystals)¹²、乳化溶液(emulsions)¹³。過去許多研究將共聚高分子以適當溶劑塗佈在固體基材上,可形成具高規則微孔洞結構之蜂窩薄膜,而將此稱之為"breath figures"圖案¹⁴。

Rayleigh¹⁵首先描述在低溫表面由水滴所形成的六角柱狀陣 列,令人驚訝的是水滴在表面極為穩定並可防止彼此接合在一起, 此所謂的"breath figures"不僅發生於低溫固態表面,在有機液體表面 亦可被觀察到,然而此高規則六角柱狀陣列在當時尚未被明確地定 義。直至1994年,由Francois等人¹⁴,發現將星狀高分子聚苯乙烯溶 解於高揮發性之有機溶劑中,在具有溼度及氣流的環境下將溶液塗 佈於表面,結果形成穩定的高分子孔洞薄膜。當薄膜上層被移除時, 可觀察到此微米級孔洞為具高規則性之六角柱狀排列,進而聯想到 蜂窩狀(honeycomb)結構,如圖2.8。



圖 2.8 蜂窩狀結構孔洞膜產生過程(A)高分子溶液之溶劑揮發(B)溶 液表面溫度降低導致水滴沉降(C)水滴於溶液表面形成六角形最密 堆積(D)高分子沉積於界面以避免水滴接合(E)溶劑及水滴揮發後孔 洞薄膜之掃描式電子顯微鏡影像圖

不久之後,Rayleigh 及Francois等研究團隊發現,所呈現之蜂窩 狀孔洞薄膜是由"breath figures"所造成。其中形成過程的確切機制至 今仍在研究當中,但許多研究已經試圖瞭解並發表這看似簡單卻具 高度規則性的材料,由數個研究中可簡單地總結其產生機制,如圖 2.8。若欲成功地製備蜂窩狀孔洞薄膜,其首要條件為使用高揮發 性、與水不互溶的有機溶劑,例如:二硫化碳、含氯溶劑。利用含 充足水分的氣流經過溶液上方,可使溶劑快速揮發,在此過程中溶液溫度將低至-6°C¹⁶。近來研究測得溶液溫度乃由室溫驟降至-12°C¹⁵,隨後水滴由潮濕環境中凝結至溶液表面而排列其上,而表面的水滴密度隨著環境中的溼度提升而增加¹⁷,水滴粒徑a將隨時間成長,此根據方程式 $a \propto kt^{1/3}$, k為氣流速度及表面溫度之函數¹⁸。

許多研究針對不同高分子模型接合不存在的問題提出解釋,例 如:發生馬諾哥尼對流(Marangonio convection¹⁹或是在高分子層周圍 的水滴形成固體外殼(solid envelope)而立即沉降¹⁷,藉由排斥或吸引 力使水滴大範圍地規則排列,因此高分子溶液層表面充滿水滴並穩 定存在,隨後使溶劑揮發、則溶液黏度增加,此可有效地固定孔洞 結構。由實際的觀點而言,雖然以此法製備規則性材料極為簡單, 但實際基礎為相當複雜的機制。此過程非恆溫、非平衡,且必須凍 結產生高規則結構的精確條件仍不明確,即使一般用以描述的許多 機制及各種因素仍然是非常模糊的,因此導致許多發表的研究乃根 據大多數經驗為主。此過程中包括許多可變因素,包括:高分子化 學性質與結構、選擇有機溶劑、表面、溫度、氣流、黏度及溼度... 等。

2.4.2 成膜機制

在成膜過程中,如圖 2.9 所示²⁰,外在環境的風速帶動溶劑快速 地揮發,使高分子表面溫度驟降至-6℃,然而此由於低溫固態、液態 表面與水氣接觸的現象被稱為"breath figure",故此結構亦可稱之為 "breath figure"。當水滴在表面處慢慢地凝結成長,由於水滴在表面 處慢慢地凝結成長,同時受到對流(convection flow)、毛細管作用力 (capillary force)的影響,促使水滴往高分子溶液/基材/空氣的三相邊界 (three phase line)移動,而後持續受到熱虹吸對流(thermocaillary convection)的影響使愈來愈多水滴紛紛往三相邊界集中、排列為整齊 的六角堆積,同時因溶劑不斷地揮發、及表面張力作用下,促使高分 子固定於邊界處的水滴、及帶動的三相邊界移往中心處,最後當水氣 完全揮發後則形成有規則的六角堆積之多孔性高分子薄膜。



圖 2.9 蜂窩狀多孔性薄膜之成膜機制

學者先後運用光散射實驗(light scattering experiment)證明上述成 膜過程的模擬架構,如圖 2.10 所示²¹。



圖 2.10 以光散射實驗觀察成膜過程中之變化(λ=650 nm), (a)~(e)分 別為不同時間下的繞射圖形

由於實驗中紀錄在時間變化的繞射圖形,使我們獲得成膜過程 中的水氣、高分子溶液與孔洞產生之間變化的資訊。首先由於繞射 圖案不規則,隨著時間增加可觀察到繞射圖案趨於整齊排列,慢慢 地由圓弧型(halo)變為六個弧形(arcs),最後形成六角堆積(hexagonal) 之排列狀態。此外將以布拉格定律(Bragg's law nλ=2dsinθ)轉換得到 孔徑大小d與時間變化,如圖 2.11 所示,藉此可明確知道水滴之成 長過程,由一開始水氣會迅速凝結於表面、並到處分散於表面各處, 隨時間增加水滴會緩慢地成長,最後當溶劑完全揮發後,將可得到 規則、穩定的蜂窩狀多孔性之高分子薄膜,並且整個過程於一分鐘 內即可完成而獲得高規則性孔洞之薄膜。



圖 2.11 以光散射紀錄成膜過程

而後 B. Francois 以水滴與溶劑、水滴與高分子溶液之間的表面張 力實驗證明,水滴之間並不會相互連結而造成不規則的孔洞,可觀察 到水滴進入高分子溶液內,水滴因為受到高分子溶液影響而立刻往內 縮,由此可推測水滴進入高分子瞬間便立即受到高分子包圍,而使彼 此沒有能力相互連結一起,同時可發現當濃度愈高、影響愈顯著,因 此我們可得知成膜過程的變化與機制之原由。

M. Srinivasarao則以甲苯(toluene)、苯(benzene)等比重較水為輕、 且與水不互溶之溶劑獲得 3D結構之薄膜,並以不同深度及方向進行 截面積觀察,因此可知薄膜規則度不受深度影響,而為內部結構極為 規則之蜂窩狀孔洞,如圖 2.12 所示²²。

此外由文獻得知,薄膜孔洞受溼度、空氣流速與高分子溶液濃度 影響甚鉅,而不同種類高分子影響排列之規則度,甚至末端官能基亦 為影響因素之一。孔洞的形成與時間呈立方反比關係(α∞kt^{1/3}),與濃 度成反比(pore size=k'/conc.),學者Martina H. Stenzel將其所做的星型 PS對濃度、溼度及孔洞之間的關係整理於圖 2.13,孔洞隨濃度增加而 減少,且濕度增加、孔洞愈大²³。



圖 2.12 以不同方向深度觀察三維結構之多孔性薄膜



圖 2.13 高分子溶液濃度及分子量與孔洞之間的關係

2.4.3 影響多孔薄膜因素

而後許多學者紛紛研究此特殊高規則的蜂窩狀高分子薄膜之形 成條件、並探討經由各項機制所造成之結果,B. Francois、O. Karthaus、M. Srinivasarao 及 M. H. Stezel 分別於 1995~2003 年間提出製備 出此種型態薄膜的成膜條件,分別敘述如下:

- (1) 溼度:高濕度環境有助於足夠的水氣凝結為水滴,一般所需的溼度均大於 50%。
- (2)空氣流速:環境中需保持一定的空氣流速,使溶劑在各時間、位置皆具有相同揮發速率,以保持溶劑與非溶劑(水氣)的交換速率。
- (3)溶劑:主要依照高分子特性而言,若具電荷性的高分子(polyion) 在溶劑中,則依電性的吸引及排斥而自身相互聚集;此外,所選 用之溶劑必須具有高揮發性、高蒸氣壓,使溶劑得以快速揮發, 保持住水滴形狀並、並使水滴與水滴間來不及相互結合。
- (4)高分子材料:所選用之高分子在溶劑中必須自然成為膠體粒狀 (micelle)或高規則之球狀結構,使其在成膜時可以彼此聚集,並在 溶液與水滴的界面處可以迅速沉澱、產生變化,有足夠能力包圍 住水滴,如星型結構高分子、末端具有特殊極性官能基、各種硬-軟嵌段共聚高分子,乃至於側鏈上具有特殊官能基或梳狀高分 子,皆可作為此型態規則的高分子薄膜材料,此外所使用的材料

另需具備與水不相溶的特性,如此方可沉澱並包圍住水滴。

2.4.4 多孔性薄膜之應用

製備由次微米至微米等級、排列成具有週期性之二維結構圖 形,對於電子學、光學或生物學而言為極重要的發現。藉由在濕度 環境下塗佈溶液,所製備之蜂窩狀高分子結構,可用以組裝新型微 結構²⁴。例如將所製備而得之蜂窩狀薄膜進行thermo annealing,由於 蜂窩狀薄膜為似蜂窩狀之六角形圖案,藉由垂直柱狀支撐而具有雙 層六角形結構,經過thermo annealing使垂直柱狀結構塌陷而成為單 層蜂窩結構,如圖2.14 (a)。亦可利用機械方式使此蜂窩狀薄膜產生 形變,拉伸彈性薄膜而獲得具橢圓或規則孔洞之微孔薄膜,如圖2.14 (b)。將各種材料填充至蜂窩狀薄膜之孔洞中,將蜂窩狀薄膜之模板 移除後,可獲得負型模板,如圖2.14 (c);以poly(dimethylsiloxane) (PDMS)彈性體為填充材料,其所製得之負型模板可用以作為微鏡陣 列(microlens arrays)。此外,利用膠帶將蜂窩狀圖案薄膜上層移除, 則可於基板表面及膠帶上發現似針墊(pincushion-like)結構,如圖2.14 (d);經由膠帶分離蜂窩狀薄膜下層及上層之結構不同,黏合於膠帶 上的上層為均勻孔洞,而在下層則為規則的小凹洞。H. Yabu等人, 以含氟高分子製備蜂窩狀結構,亦利用膠帶移除上層所獲得之似針 墊結構,具有超疏水特性,如圖2.15所示25。



圖 2.14 由自組裝蜂窩膜之新型微結構組裝應用



圖 2.15 以含氟高分子製作似針墊結構以形成超疏水材料

2.5 參考文獻

- 1. 高分子合成新技術,化學工業出版社,王建國編著
- 2. Wang, J. S.; Matyjaszewski, K. J. Am. Chem. Soc. 1995, 114, 5614.
- Kato, M.; Kamigaito, M.; Sawamoto, M. *Macromolecules* 1995, 28, 1721.
- 4. Matyjaszewski, K.; Xia, J. Chem. Rev. 2001, 101, 2921.
- P. D. Syber, W. H. Beever, J. K. Stille, *Macromolecules* 1981, 14, 493
- 6. Khandpur et al., *Macromolecules*, **1995**, 28, 8796
- 7. S. Förster and M. Antonietti, Adv. Mater. 1998, 10, 195
- 8. T. W. Chung et al., *Polymer* **2004**, 45, 1591
- S. K. Jewarjka, U. Chatterjee, J. Polym. Sci.: Part A: Polym. Chem., 2006, 44, 1841
- B. deBoer, U. Stalmach, H. Nijland, G. Hadziioannou, *Adv. Mater*.
 2000, 12, 1581
- 11. S. Jenekhe, X. Chen, Science 1999, 283, 372
- O. D. Velev, T. A. Jede, R. F. Lobo, A. M. Lenhoff, *Nature* 1997, 389, 447
- 13. A. Imhof, D. J, Pine, Nature 1997, 389, 948
- 14. G. Widawski, M. Rawiso, B. Francois, Nature 1994, 369, 387
- M. H. Stenzel, C. B. Kowollik, T. P. Davis, J. Polym. Sci.: Part A: Poly. Chem., 2006, 44, 2363
- T. Nishikawa, J. Nishida, R. Ookura, S. I. Nishimura, S. Wada, T. Karino, M. Shimomura, *Mater Sci Eng C* 1999, 8, 495
- 17. O. Karthaus, N. Maruyama, X. Cieren, M. Shimomura, H. Hasegawa,

T. Hashimoto, *Langmuir* **2000**, 16, 6071

- 18. O. Pitois, B. Francois, Colloid Polym. Sci. 1999, 277, 574
- Srinivasarao, M.; Collings, D.; Philips, A.; Patel, S. Science 2001, 292, 79.
- 20. (a)N. Maruyama, T. Koito, J. Nishida, T. Sawadaishi, X. Cieren, K. Ijiro, O. Karthaus, M. Shimomura, *Thin Solid Films* 1998, 854, 327
 (b) E. Serhatli, T. Kacar, *J. Appl. Poly. Sci.* 2006, 99, 3187
- 21. O. Karthaus, N. Maruyama, X. Cieren, M. Shimomura, H. Hasegawa,T. Hashimot, *Langmuir*2000, 16, 6701
- M. Srinivasarao, D. Collings, A. Philips, S. Patel, *Science* 2001, 292, 79
- 23. M. H. Stenzel, T. P. Davis, A. G. Fane, *J Mater. Chem.* 2003, 13, 2090
- 24. H. Yabu, and M. Shimomura, Langmuir 2006, 22, 4992
- H. Yabu, M. Takebayashi, M. Tanaka, M. Shimomura, *Langmuir* 2005, 21, 3235